



2SB647 (3CG647)

2SB647A (3CG647A)

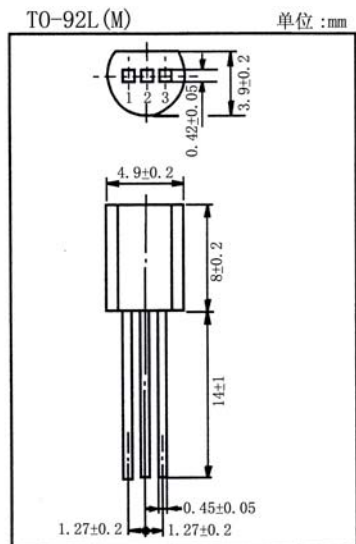
硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于低频功率放大,与 2SD667 (3DG667)/2SD667A (3DG667A) 互补。

Purpose: Low frequency power amplifier, complementary pair with 2SD667 (3DG667) /2SD667A (3DG667A)。

极限参数/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CBO}	-120	V
V_{CEO} 2SB647 2SB647A	-80 -100	V
V_{EBO}	-5.0	V
I_C	-1.0	A
I_{CP}	-2.0	A
P_C	900	mW
T_j	150	°C
T_{stg}	-55~150	°C



引脚: 1.E 2.C 3.B

电性能参数/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Condition		数值 Symbol			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CBO}	$I_C = -10 \mu A$	$I_E = 0$	-120			V
V_{CEO} 2SB647 2SB647A	$I_C = -1.0 mA$	$R_{BE} = \infty$	-80 -100			V
V_{EBO}	$I_E = -10 \mu A$	$I_C = 0$	-5.0			V
I_{CBO}	$V_{CB} = -100V$	$I_E = 0$			-10	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -5.0V$	$I_C = -150mA$	60		320	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5.0V$	$I_C = -500mA$	30			
$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500mA$	$I_B = -50mA$			-1.0	V
V_{BE}	$V_{CE} = -5.0V$	$I_C = -150mA$			-1.5	V
f_T	$V_{CE} = -5.0V$	$I_C = -150mA$		140		MHz
C_{ob}	$V_{CB} = -10V$	$I_E = 0$ $f = 1.0MHz$		12		pF

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ Classifications: B:60~120 C:100~200 D:160~320



2SB647 (3CG647)

2SB647A (3CG647A)

